A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2012年12月4日根據中國法律成立為一家有限公司，並於2022年6月28日改制為一家股份有限公司。我們於2025年12月24日根據公司條例第16部於香港公司註冊處處長登記為一家非香港公司，且已於香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。翁美儀女士已獲委任為本公司授權代表，以於香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司於中國成立，我們的業務營運須遵守中國相關法律法規。中國法律相關方面及我們的組織章程細則的概要載於本文件附錄三、四及五「稅項及外匯」、「主要法律及監管條文概要」及「組織章程細則概要」。

2. 本公司股本變動

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，緊接本文件日期前兩年內本公司股本並無變動。

3. 我們附屬公司的股本變動

有關公司資料概要及我們主要附屬公司的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註1。

本公司以下附屬公司於緊接本文件日期前兩年內成立：

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本
橫琴拓緯.....	中國	2025年2月28日	人民幣5,000,000元
威兆舟山.....	中國	2025年9月4日	人民幣80,000,000元

緊接本文件日期前兩年內我們附屬公司的股本並無變更。

4. 股東決議案

於2025年12月12日，股東決議案獲通過，據此，其中包括：

(a) 待完成[**編纂**]後，細則獲批准及採納，自[**編纂**]起生效；

(b) [**編纂**]（包括[**編纂**]、[**編纂**]及[**編纂**]）及[**編纂**]獲批，且董事獲授權根據[**編纂**]配發及發行[**編纂**]；

(c) 將予[**編纂**]的H股數目最高將為[**編纂**]完成後及[**編纂**]獲行使前本公司股本總額的[**編纂**]%，且就此授出的[**編纂**]不得超過根據[**編纂**]初步發行的H股數目的[**編纂**]%；

(d) 待[**編纂**]完成後，授予董事會一般授權可於直至將於[**編纂**]後舉行的下屆股東週年大會結束日期或股東通過一項特別決議案以撤銷或更改有關授權的日期（以較早者為準）期間內按董事會全權酌情認為合適的條款及條件、為有關目的及向有關人士隨時配發及發行股份，及對組織章程細則進行必要的修改，惟將予發行的股份數目不得超過於授出一般授權決議案當日已發行股份數目的20%；及

(e) 待進行中國證監會備案程序後，於[**編纂**]完成後，[**編纂**]股非上市股份將按一比一的基準轉換為H股。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

本集團任何成員公司於本文件日期前兩年內已訂立以下屬重大或可能屬重大的合約（並非由或擬由本公司於日常業務過程中訂立的合約）：

(a) [●]；及

(b) [**編纂**]。

2. 我們的知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1		9	本公司	中國	16841041	2036年6月27日
2	威兆	9	本公司	中國	52970332	2031年11月27日
3	威兆	42	本公司	中國	56433072	2032年2月6日
4	vergiga	9	本公司	中國	62152994	2032年7月6日
5	vergiga	42	本公司	中國	62159188	2032年7月13日
6	vergiga semiconductor	9	本公司	中國	62169758	2033年8月27日
7	威兆半导体 vergiga semiconductor	9	本公司	中國	62152965	2032年10月27日
8		9	本公司	台灣	02195734	2032年1月15日
9		9	本公司	新加坡	40202113542Y	2031年6月8日
10 . . .		9	本公司	印度	5000273	2031年6月10日
11 . . .		9	本公司	香港	305654999	2031年6月10日
12 . . .		9	本公司	馬來西亞	TM2021016203	2031年6月9日
13 . . .		9	本公司	日本	6532292	2032年3月23日
14 . . .		9	本公司	韓國	40-2018-0097034	2029年4月11日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
1	一種終端結構、半導體器件及製作方法	發明專利	珠海威兆	ZL202110651512.4	2041年6月9日
2	一種終端結構、半導體器件及製作方法	發明專利	珠海威兆	ZL202110651513.9	2041年6月9日
3	埋層終端結構及其製備方法	發明專利	珠海浩辰	ZL202110695201.8	2041年6月21日
4	複合終端結構及其製備方法	發明專利	珠海浩辰	ZL202110695000.8	2041年6月21日
5	超結MOSFET器件及芯片	發明專利	本公司	ZL202110554780.4	2041年5月19日
6	一種基於SGT-MOSFET的電壓採樣結構	發明專利	本公司	ZL202210048704.0	2042年1月16日
7	一種集成式電壓採樣的SGT-MOSFET器件	發明專利	本公司	ZL202210048703.6	2042年1月16日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
8	屏蔽柵極金氧半場效晶體管元胞結構、晶體管及製造方法	發明專利	本公司	ZL202210049709.5	2042年1月16日
9	一種IGBT器件及其製造方法	發明專利	本公司	ZL202210062869.3	2042年1月19日
10	一種帶溫度採樣功能的屏蔽柵器件	發明專利	本公司	ZL202210403811.0	2042年4月17日
11	一種半導體器件、終端結構及其製造方法	發明專利	本公司	ZL202210227409.1	2042年3月9日
12	一種IGBT器件及其製造方法	發明專利	本公司	ZL202210327695.9	2042年3月30日
13	槽柵超結VDMOS器件、芯片及終端設備	發明專利	本公司	ZL202110581224.6	2041年5月25日
14	一種超結MOSFET器件的仿真方法	發明專利	本公司	ZL202210485117.8	2042年5月5日
15	一種改善短路特性的碳化硅MOS器件	發明專利	本公司	ZL202210502977.8	2042年5月9日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
16	一種雙溝道MOSFET器件及其製造方法	發明專利	本公司	ZL202210631851.0	2042年6月6日
17	一種具有導通壓降自鉗位的半導體器件及其製造方法	發明專利	本公司	ZL202210777870.4	2042年7月3日
18	一種具有溝道二極管的階梯溝槽柵SiC MOSFET結構及其製備方法	發明專利	本公司	ZL202210876258.2	2042年7月24日
19	一種具有雙溝道二極管的溝槽柵SiC MOSFET器件及其製備方法	發明專利	本公司	ZL202210876407.5	2042年7月24日
20	一種超結VDMOS新結構及其製備方法	發明專利	本公司	ZL202211078330.3	2042年9月4日
21	一種超結MOSFET的製備方法	發明專利	本公司	ZL202110574914.9	2041年5月24日
22	一種超結MOSFET	發明專利	本公司	ZL202211077819.9	2042年9月4日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
23	一種變頻器MOSFET的散熱裝置及散熱方法	發明專利	本公司	ZL202210973299.3	2042年8月14日
24	一種屏蔽柵MOSFET及製作方法	發明專利	本公司	ZL202111025942.1	2041年9月1日
25	一種快恢復二極管及其製備方法	發明專利	本公司	ZL202211234158.6	2042年10月9日
26	快恢復二極管及其製備方法	發明專利	本公司	ZL202211233564.0	2042年10月9日
27	一種反饋式MOSFET溝槽的清洗乾燥方法、裝置及介質	發明專利	本公司	ZL202211142961.7	2042年9月19日
28	一種基於IGBT高溫特性的有限元建模方法及系統	發明專利	本公司	ZL202211194490.4	2042年9月28日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
29	一種IGBT故障運行參數的動態模擬方法及系統	發明專利	本公司	ZL202211245103.5	2042年10月11日
30	半導體器件及其製造方法	發明專利	本公司	ZL202211498206.2	2042年11月27日
31	絕緣柵雙極型晶體管	發明專利	本公司	ZL202211417218.8	2042年11月13日
32	絕緣柵雙極型晶體管的終端耐壓調整方法	發明專利	本公司	ZL202211481979.X	2042年11月23日
33	絕緣柵雙極型晶體管	發明專利	本公司	ZL202211482984.2	2042年11月23日
34	絕緣柵雙極型晶體管的製作方法及絕緣柵雙極型晶體管	發明專利	本公司	ZL202211070222.1	2042年8月31日
35	一種絕緣柵雙極型晶體管	發明專利	本公司	ZL202211029687.2	2042年8月24日
36	高壓碳化硅功率器件終端及其製造方法	發明專利	本公司	ZL202310047582.8	2043年1月30日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
37	半導體器件	發明專利	本公司	ZL202310075946.3	2043年2月6日
38	絕緣柵雙極型晶體管及其載流子濃度控制方法	發明專利	本公司	ZL202310256833.3	2043年3月16日
39	半導體器件	發明專利	本公司	ZL202310534527.1	2043年5月11日
40	半導體器件	發明專利	本公司	ZL202310534526.7	2043年5月11日
41	半導體器件及其製造方法	發明專利	本公司	ZL202310614487.1	2043年5月28日
42	碳化硅MOSFET器件及其製造方法	發明專利	本公司	ZL202310614471.0	2043年5月28日
43	具有高UIS能力的碳化硅MOSFET器件及其製造方法	發明專利	本公司	ZL202310614478.2	2043年5月28日
44	半導體縱向器件及其生產方法	發明專利	本公司	ZL202111213211.X	2041年10月17日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
45	一種半導體縱向器件及其生產方法	發明專利	本公司	ZL202111213878.X	2041年10月17日
46	半導體器件及其製造方法	發明專利	本公司	ZL202310844509.3	2043年7月10日
47	半導體器件及其製備方法	發明專利	本公司	ZL202310844510.6	2043年7月10日
48	氮化鎵功率器件(一種氮化鎵功率器件及其製備方法)	發明專利	本公司	ZL202410065349.7	2044年1月16日
49	氮化鎵雙向功率器件(一種氮化鎵雙向功率器件及其製備方法)	發明專利	本公司	ZL202410065348.2	2044年1月16日
50	一種屏蔽柵溝槽型MOSFET器件及其製備方法	發明專利	本公司	ZL202410391005.5	2044年4月1日
51	一種抗dv/dt的SGT器件	發明專利	本公司	ZL202011065162.5	2040年9月29日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
52	具有均勻摻雜溝道的屏蔽柵MOSFET器件及加工工藝	發明專利	本公司	ZL202011219018.2	2040年11月3日
53	SGT器件及其製備方法	發明專利	本公司	ZL202410186179.8	2044年2月19日
54	一種具有ESD保護結構的半導體器件及其製備方法	發明專利	本公司	ZL202411439017.7	2044年10月14日
55	一種溝槽柵IGBT器件	發明專利	珠海浩辰	ZL202010928662.0	2040年9月6日
56	一種具有浮空結構的溝槽柵IGBT器件	發明專利	珠海浩辰	ZL202110153581.2	2041年2月3日
57	一種集成NPN穿通三極管的屏蔽柵MOSFET器件	發明專利	本公司	ZL202011197262.3	2040年10月29日
58	一種浮空結構與溝槽分立的溝槽柵IGBT器件	發明專利	珠海浩辰	ZL202110153724.X	2041年2月3日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
59	一種複合溝槽分立柵功率器件及其加工工藝	發明專利	本公司	ZL202011427090.4	2040年12月8日
60	一種溝槽MOS單元及其製備方法	發明專利	本公司	ZL201410536089.3	2034年10月10日
61	一種半導體器件結構	發明專利	本公司	ZL201610606441.5	2036年7月28日
62	基於橫向多溝道結構的PiN二極管及其製備方法	發明專利	本公司	ZL201710310424.1	2037年5月4日
63	一種縱向多重PN結的VDMOS分壓環的設計方法	發明專利	本公司	ZL201811550606.7	2038年12月17日
64	半導體器件的製造方法(一種絕緣柵雙極型晶體管製作方法)	發明專利	本公司	ZL202211442458.3	2042年11月16日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
65	半導體功率器件及其製備方法(一種高密度功率器件的結構及其製備方法)	發明專利	本公司	ZL202510743104.X	2045年6月4日
66	半導體功率器件及其製備方法(一種屏蔽柵溝槽型晶體管器件及其製備方法)	發明專利	本公司	ZL202510858120.3	2045年6月24日
67	氮化鎵功率器件及其製備方法(一種氮化鎵功率器件及其製備方法)	發明專利	本公司	ZL202510858848.6	2045年6月24日
68	一種IGBT芯片版圖金屬層	實用新型	珠海浩辰	ZL202021820854.1	2030年8月26日
69	一種溝槽柵IGBT器件	實用新型	珠海浩辰	ZL202021934492.9	2030年9月6日
70	一種終端結構及半導體器件	實用新型	珠海浩辰	ZL202121305452.2	2031年6月9日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
71	一種終端結構及半導體器件	實用新型	珠海浩辰	ZL202121306194.X	2031年6月9日
72	複合終端結構	實用新型	珠海浩辰	ZL202121395001.2	2031年6月21日
73	埋層終端結構	實用新型	珠海浩辰	ZL202121395102.X	2031年6月21日
74	一種浮空結構與溝槽分立的溝槽柵IGBT器件	實用新型	珠海浩辰	ZL202120354474.1	2031年2月3日
75	一種具有浮空結構的溝槽柵IGBT器件	實用新型	珠海浩辰	ZL202120329605.0	2031年2月3日
76	一種NPN三明治柵結構的溝槽MOSFET器件	實用新型	本公司	ZL202022483133.2	2030年10月29日
77	一種具有均勻摻雜溝道的屏蔽柵MOSFET器件	實用新型	本公司	ZL202022530296.1	2030年11月3日
78	一種抗dv/dt的SGT器件	實用新型	本公司	ZL202022224120.3	2030年9月29日
79	一種抗EMI的SGT器件	實用新型	本公司	ZL202022224211.7	2030年9月29日
80	一種肖特基二極管	實用新型	本公司	ZL201720653343.7	2027年6月5日
81	一種DMOS截止環	實用新型	本公司	ZL201720648610.1	2027年6月5日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
82	一種集成NPN穿通三極管的屏蔽柵MOSFET器件	實用新型	本公司	ZL202022485628.9	2030年10月29日
83	一種具有雙向ESD保護能力的SGT MOSFET器件	實用新型	本公司	ZL202022484962.2	2030年10月29日
84	一種複合溝槽分立柵功率器件	實用新型	本公司	ZL202022933544.7	2030年12月8日
85	槽柵超結VDMOS器件及芯片	實用新型	本公司	ZL202121154194.2	2031年5月25日
86	超結MOSFET器件	實用新型	本公司	ZL202121092565.9	2031年5月19日
87	超結MOSFET	實用新型	本公司	ZL202121129551.X	2031年5月24日
88	半導體器件	實用新型	本公司	ZL202121045231.6	2031年5月13日
89	超結MOSFET終端	實用新型	本公司	ZL202121253482.3	2031年6月3日
90	超結功率MOSFET	實用新型	本公司	ZL202120976676.X	2031年5月7日
91	一種具有PSG介質保護層的SGT器件	實用新型	本公司	ZL202023248067.7	2030年12月27日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
92	一種具有介質保護層的SGT器件	實用新型	本公司	ZL202023234842.3	2030年12月27日
93	一種屏蔽柵MOSFET	實用新型	本公司	ZL202122114620.6	2031年9月1日
94	屏蔽柵MOSFET器件和芯片	實用新型	本公司	ZL202122093215.0	2031年8月30日
95	半導體器件	實用新型	本公司	ZL202122511036.4	2031年10月17日
96	一種半導體器件	實用新型	本公司	ZL202122511154.5	2031年10月17日
97	半導體封裝結構	實用新型	本公司	ZL202223599497.2	2032年12月28日
98	半導體封裝結構	實用新型	本公司	ZL202223599454.4	2032年12月28日
99	高壓二極管	實用新型	本公司	ZL202223483800.2	2032年12月20日
100	二極管器件	實用新型	本公司	ZL202223524744.2	2032年12月20日
101	半導體器件	實用新型	本公司	ZL202223423034.0	2032年12月15日
102	二極管器件	實用新型	本公司	ZL202223489328.3	2032年12月20日
103	玻璃清潔設備	實用新型	珠海威兆	ZL202422039053.6	2034年8月20日
104	一種高效加熱解膠機(熱解膠機方案)	實用新型	珠海威兆	ZL202422672712.X	2035年10月27日

序號	專利	專利類型	專利權人	專利編號	屆滿日期
105	一種可調晶圓夾具及解膠機(熱解膠機方案)	實用新型	珠海威兆	ZL202422671145.6	2034年10月31日
106	玻璃檢測設備	實用新型	珠海威兆	ZL202422083209.0	2034年8月25日
107	半導體金屬清洗設備	實用新型	珠海威兆	ZL202422210936.9	2034年9月8日
108	半導體金屬清洗設備	實用新型	珠海威兆	ZL202422292481.X	2034年9月18日
109	旋轉式玻璃超聲波清潔設備	實用新型	珠海威兆	ZL202422188192.5	2034年9月4日
110	一種防飛濺的蒸鍍裝置	實用新型	珠海威兆	ZL202520986725.6	2035年5月18日
111	晶圓拆貼一體化轉運台	實用新型	珠海威兆	ZL202521158524.3	2035年6月5日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	專利權人	申請編號	申請日期
1	一種帶靜電保護結構的MOSFET器件及其製備方法(一種帶靜電防護結構的MOSFET設計方法)	發明專利	本公司	202410276181.4	2024年3月12日

序號	專利	專利類型	專利權人	申請編號	申請日期
2	場效應晶體管及其製造方法(3一種碳化矽MOSFET器件及其製造方法)	發明專利	本公司	202310618493.4	2023年5月29日
3	金氧半場效晶體管及其製造方法(一種碳化矽MOSFET器件及其製造方法)	發明專利	本公司	202310614740.3	2023年5月29日
4	快恢復二極管的製備方法(一種快恢復二極管的製造方法)	發明專利	本公司	202310133058.2	2023年2月7日
5	半導體器件(一種功率半導體芯片裝置)	發明專利	本公司	202211626871.5	2022年12月16日
6	半導體封裝結構(一種絕緣柵雙極型晶體管製作方法)	發明專利	本公司	202211715252.3	2022年12月29日
7	半導體封裝結構(一種絕緣柵雙極型晶體管製作方法)	發明專利	本公司	202211717716.4	2022年12月29日
8	二極管器件(一種高壓二極管)	發明專利	本公司	202211652417.7	2022年12月21日

序號	專利	專利類型	專利權人	申請編號	申請日期
9	二極管器件(一種溝槽式的高壓二極管)	發明專利	本公司	202211655601.7	2022年12月21日
10 . . .	高壓二極管(一種降低EMI的高壓二極管)	發明專利	本公司	202211652391.6	2022年12月21日
11 . . .	具有深溝槽的埋層終端及其製造方法(一種具有深溝槽的埋層終端結構)	發明專利	本公司	202211737562.5	2022年12月29日
12 . . .	晶圓拆貼一體化轉運台(四分之一晶圓(8K4)安裝工藝改進)	實用新型	本公司	202521158524.3	2025年6月6日
13 . . .	一種防飛濺的蒸鍍裝置(一種具有防止鎳材料飛濺功能的鎢坩堝套)	實用新型	本公司	202520986725.6	2025年5月19日
14 . . .	晶圓貼膜防呆裝置(手動貼膜機防呆發明改進)	實用新型	本公司	202521438554.X	2025年7月9日
15 . . .	一種晶圓的輔助環管理治具(鋼環輔助管理治具)	實用新型	本公司	202521851045X	2025年8月28日

序號	專利	專利類型	專利權人	申請編號	申請日期
16 . . .	一種單顆晶圓檢測治具(Die檢查輔助治具)	實用新型	本公司	2025218511912	2025年8月28日
17 . . .	一種用於半導體輔料的周轉推車(一種耐酸堿的套箱推車)	實用新型	本公司	2025219261878	2025年9月8日
18 . . .	一種用於晶圓的手動切膜旋轉治具(一種具有防切偏且效率提升的手動切膜旋轉台)	實用新型	本公司	2025219261914	2025年9月8日
19 . . .	一種用於半導體清洗的提手治具(一種防止酸洗作業時滴酸的清洗提手)	實用新型	本公司	2025219557877	2025年9月11日
20 . . .	一種用於半導體鍍膜的襯托治具(一種能使真空鍍膜晶圓實現整面導電功能的十爪鋼圈)	實用新型	本公司	202521997900.8	2025年9月17日
21 . . .	一種用於半導體的防飛濺異形蒸鍍裝置(一種具有蒸發鍍膜防飛濺功能的坩堝套)	實用新型	本公司	2025219557858	2025年9月11日

序號	專利	專利類型	專利權人	申請編號	申請日期
22 . . .	垂直雙擴散半導體功率器件(半導體功率器件及其製備方法)	實用新型	本公司	2025227344904	2025年12月24日

(c) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的著作權：

序號	著作權	註冊人	註冊編號	註冊日期
1. . .	威兆半導體器件選型系統V1.0	本公司	2019SR1336946	2019年12月11日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	屆滿日期
1. . .	vgsemi.com	本公司	2027年11月11日

除上述外，截至最後實際可行日期，概無我們認為對我們業務而言屬重大的其他商標、專利或其他知識產權或工業產權。

(e) 集成電路布圖設計

截至最後實際可行日期，我們已保留以下我們認為就業務而言屬重要的集成電路布圖設計：

序號	名稱	註冊人	註冊編號	屆滿日期
1. . .	VS8068AD	本公司	BS.195601416	2029年7月18日
2. . .	VS6018BS	本公司	BS.195601424	2029年7月18日
3. . .	VS6410AS	本公司	BS.195601394	2029年7月18日
4. . .	VSD950N70HS	本公司	BS.205525733	2030年4月25日
5. . .	VSE002N03MS-G	本公司	BS.205525741	2030年4月25日
6. . .	VS3508AE	本公司	BS.195601386	2029年7月18日
7. . .	VS6412AE	本公司	BS.195601408	2029年7月18日

序號	名稱	註冊人	註冊編號	屆滿日期
8...	VS6411AS	本公司	BS.205602495	2030年11月15日
9...	VSP003N10MS-G	本公司	BS.205532411	2030年5月17日
10...	VS12022CAAQ	本公司	BS.205532454	2030年5月17日
11...	VS0009N06MS-G	本公司	BS.20553242X	2030年5月17日
12...	VS6614GS	本公司	BS.205605842	2030年11月22日
13...	VS4110AT	本公司	BS.205605834	2030年11月22日
14...	VS150N08BT	本公司	BS.205605710	2030年11月22日
15...	VSI008N10MS3-K	本公司	BS.205602509	2030年11月15日
16...	VS3618BE	本公司	BS.205605826	2030年11月22日
17...	VS3510AE	本公司	BS.205602479	2030年11月15日
18...	VSP004N10MS-G	本公司	BS.20560580X	2030年11月22日
19...	VSI008N10MS3	本公司	BS.205602487	2030年11月15日
20...	VS1606GS	本公司	BS.205605818	2030年11月22日
21...	DMOS功率芯片VS6613GS	本公司	BS.215589955	2031年7月26日
22...	DMOS功率芯片VS4410AT	本公司	BS.215601467	2031年8月17日
23...	DMOS功率芯片VST006N15HS-G	本公司	BS.215601351	2031年8月17日
24...	DMOS功率芯片VS12021CA6Q	本公司	BS.215589785	2031年7月26日
25...	DMOS功率芯片VS12040CA6Q	本公司	BS.21558984X	2031年7月26日
26...	DMOS功率芯片VS12015CAAQ	本公司	BS.215589696	2031年7月26日
27...	DMOS功率芯片VS12010CACQ	本公司	BS.215589688	2031年7月26日
28...	DMOS功率芯片VS20270CA4Q	本公司	BS.215589890	2031年7月26日
29...	DMOS功率芯片VS4401ATH	本公司	BS.215601408	2031年8月17日

序號	名稱	註冊人	註冊編號	屆滿日期
30...	DMOS功率芯片VS8402AMH	本公司	BS.215601491	2031年8月17日
31...	DMOS功率芯片VSE007N04MS-G	本公司	BS.215601424	2031年8月17日
32...	DMOS功率芯片VSE009NE6MS-G	本公司	BS.215601475	2031年8月17日
33...	DMOS功率芯片VSP009N15HS-G	本公司	BS.215601440	2031年8月17日
34...	DMOS功率芯片VS1605APM	本公司	BS.215601335	2031年8月17日
35...	DMOS功率芯片VST085N65HS	本公司	BS.215608100	2031年8月26日
36...	DMOS功率芯片VSP003N10HS-G	本公司	BS.215601432	2031年8月17日
37...	DMOS功率芯片VS6616GS	本公司	BS.215589963	2031年7月26日
38...	DMOS功率芯片VS20031CA6Q	本公司	BS.215589971	2031年7月26日
39...	DMOS功率芯片VS20100CA4Q	本公司	BS.21558998X	2031年7月26日
40...	DMOS功率芯片VSP004N10MS-K	本公司	BS.215589998	2031年7月26日
41...	DMOS功率芯片VST012N12MS-G	本公司	BS.215608119	2031年8月26日
42...	DMOS功率芯片VS40200AT	本公司	BS.215608097	2031年8月26日
43...	DMOS功率芯片VSP007N12MS-G	本公司	BS.215608127	2031年8月26日

序號	名稱	註冊人	註冊編號	屆滿日期
44...	DMOS功率芯片VS3615GE	本公司	BS.215601394	2031年8月17日
45...	FRD功率芯片HCDD5F65H1	本公司	BS.225620995	2032年11月27日
46...	FRD功率芯片HCDW20F120S1	本公司	BS.225621002	2032年11月27日
47...	FRD功率芯片HCDW40F65H1	本公司	BS.225620936	2032年11月27日
48...	FRD功率芯片HCDW40F120S1	本公司	BS.225621029	2032年11月27日
49...	FRD功率芯片HCDW75F120S1	本公司	BS.225621037	2032年11月27日
50...	IGBT功率芯片HCFF150R12KAH1	本公司	BS.225620960	2032年11月27日
51...	IGBT功率芯片HCKD5N65AM2	本公司	BS.225621053	2032年11月27日
52...	IGBT功率芯片HCKW25N120H2	本公司	BS.225621061	2032年11月27日
53...	IGBT功率芯片HCKW40N120CS2	本公司	BS.22562107X	2032年11月27日
54...	IGBT功率芯片HCKW40N120H1	本公司	BS.225620987	2032年11月27日
55...	IGBT功率芯片HCKW60N65BH2A	本公司	BS.225622874	2032年12月1日
56...	IGBT功率芯片HCKW75N65BH2	本公司	BS.225622866	2032年12月1日
57...	SGT功率芯片VS3603GPMT	本公司	BS.225622815	2032年12月1日
58...	SGT功率芯片VS3620GEMC	本公司	BS.225622807	2032年12月1日
59...	SGT功率芯片VS4833GE	本公司	BS.225622858	2032年12月1日

序號	名稱	註冊人	註冊編號	屆滿日期
60...	SGT功率芯片VS8802GPHT	本公司	BS.225622823	2032年12月1日
61...	SGT功率芯片VSP002N03MST-G	本公司	BS.22562284X	2032年12月1日
62...	DMOS功率芯片VSU60R030HS-F	本公司	BS.225625970	2032年12月11日
63...	DMOS功率芯片VSU040N65HS-F	本公司	BS.225625962	2032年12月11日
64...	T-DMOS功率器件芯片 VSP003N06MS-G	本公司	BS.225625938	2032年12月11日
65...	SGT MOS功率器件芯片 VS30025CACQ	本公司	BS.225625989	2032年12月11日
66...	T-DMOS功率器件芯片 VS24170CA4Q	本公司	BS.225625954	2032年12月11日
67...	T-DMOS功率器件芯片 VS24025CAAQ	本公司	BS.225625997	2032年12月11日
68...	T-DMOS功率器件芯片 VS6832DS-AG	本公司	BS.225625946	2032年12月11日
69...	T-DMOS功率器件芯片VS4602AP	本公司	BS.225625903	2032年12月11日
70...	T-DMOS功率芯片VS24015CACQ	本公司	BS.225628112	2032年12月15日
71...	T-DMOS功率器件芯片 VST015N15HS-G	本公司	BS.22562804X	2032年12月15日
72...	T-DMOS功率器件芯片 VSM008N15HS-G	本公司	BS.225628066	2032年12月15日

序號	名稱	註冊人	註冊編號	屆滿日期
73...	T-DMOS功率器件芯片 VSM004N15HS-G	本公司	BS.225628090	2032年12月15日
74...	T-DMOS功率器件芯片 VS24080CA6Q	本公司	BS.225628104	2032年12月15日
75...	DMOS功率芯片VS4603DM6	本公司	BS.23561498X	2033年12月28日
76...	DMOS功率芯片VS6604GP	本公司	BS.235614998	2033年12月28日
77...	DMOS功率芯片VSO009N06MS-GA	本公司	BS.235615005	2033年12月28日
78...	DMOS功率芯片VSP004N10MSC-G	本公司	BS.235615013	2033年12月28日
79...	DMOS功率芯片VSP007P06MS	本公司	BS.235614971	2033年12月28日
80...	DMOS功率芯片VSU040N65HS3	本公司	BS.235614955	2033年12月28日
81...	SGT MOS功率芯片VS1891GKH	本公司	BS.235614963	2033年12月28日
82...	Trench MOS功率芯片VS3618AP	本公司	BS.245502815	2034年1月14日
83...	SGT MOS功率芯片VS1891GMH	本公司	BS.245607242	2034年12月30日
84...	Trench MOS功率芯片VS3518AE	本公司	BS.245607331	2034年12月30日
85...	Trench MOS功率芯片VS3618AE	本公司	BS.245607218	2034年12月30日
86...	Trench MOS功率芯片VS3622DE	本公司	BS.24560734X	2034年12月30日
87...	Trench MOS功率芯片VS3698AP	本公司	BS.245607234	2034年12月30日

序號	名稱	註冊人	註冊編號	屆滿日期
88...	SGT MOS功率芯片VS4620GEMC	本公司	BS.245607250	2034年12月30日
89...	SGT MOS功率芯片VS4802GPHT	本公司	BS.245607277	2034年12月30日
90...	DMOS功率芯片VS3610AE	本公司	BS.245607293	2034年12月30日
91...	DMOS功率芯片VS6614DS	本公司	BS.245607285	2034年12月30日
92...	DMOS功率芯片VS6614GE	本公司	BS.245607307	2034年12月30日
93...	DMOS功率芯片VS40200AP	本公司	BS.245607358	2034年12月30日
94...	DMOS功率芯片VSD011N10HS-G	本公司	BS.245607323	2034年12月30日
95...	DMOS功率芯片VSP003N08HS-GA	本公司	BS.245607366	2034年12月30日
96...	DMOS功率芯片VSD007P06MS	本公司	BS.245607374	2034年12月30日
97...	芯片級封裝DMOS芯片VS12022CZAQ	珠海威兆	BS.25553700X	2035年5月20日
98...	芯片級封裝DMOS芯片VS12040CZ6Q	珠海威兆	BS.255536984	2035年5月20日
99...	芯片級封裝DMOS芯片VS20100CZ4Q	珠海威兆	BS.255536992	2035年5月20日
100..	芯片VGIG55A0	本公司	BS.255596995	2035年12月1日
101..	芯片VGIG55B0	本公司	BS.255597002	2035年12月1日

序號	名稱	註冊人	註冊編號	屆滿日期
102..	SGT MOS 功率芯片VS4653GPHT	本公司	BS.255604602	2035年12月24日
103..	SGT MOS 功率芯片VS8801GKH	本公司	BS.255604610	2035年12月24日
104..	Trench MOS 功率芯片VSE2R5N03MS	本公司	BS.255604629	2035年12月24日
105..	SGT MOS 功率芯片QH4007GPHT	本公司	BS.255604580	2035年12月24日
106..	DMOS 功率芯片VSP001N06HST-G	本公司	BS.255604637	2035年12月24日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事及最高行政人員的權益

緊隨[**編纂**]完成後（假設[**編纂**]未獲行使），董事及最高行政人員於本公司或我們相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有於H股[**編纂**]後隨即須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉載列如下：

(i) 於本公司的權益

股東名稱	權益性質[1]	所持股份或相關股份數目及類別	截至最後實際可行日期所持相關類別股份或相關股份的持股量	[編纂]後於相關類別股份的概約持股量[2]
李先生	實益擁有人	24,251,965股股份	39.19%	[**編纂**]%

股東名稱	權益性質[1]	所持股份或相關股份數目及類別	截至最後實際可行日期所持相關類別股份或相關股份的持股量	[編纂]後於相關類別股份的概約持股量[2]
	受控法團權益[3]	13,979,487股股份	22.59%	[**編纂**]%

附註：

(1) 所述所有權益均為好倉。

(2) 該計算乃基於緊隨[**編纂**]完成後（假設[**編纂**]未獲行使）已發行股份總數為[**編纂**]股得出。

(3) 截至最後實際可行日期，舟山拓緯由李先生作為其普通合夥人持有88%及由李先生的配偶吳少丹女士持有12%。舟山集成由李先生作為其普通合夥人持有約90.15%及由35名有限合夥人持有約9.85%，而該等有限合夥人均為我們的現任僱員及持有舟山集成合夥權益不足10%的獨立第三方。根據證券及期貨條例，李先生被視為於舟山拓緯及舟山集成所持股份中擁有權益。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－公司架構」及「主要股東」。

(ii) 於相聯法團的權益

據董事所知，緊隨[**編纂**]完成後，概無董事或最高行政人員將直接或間接於本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有權益。

(b) 主要股東的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[**編纂**]及非上市股份轉換為H股完成後，董事並不知悉有任何其他人士（董事或行政總裁除外）將於我們的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司或本集團任何其他成員公司已發行有投票權股份中擁有10%或以上權益。

2. 董事的服務合約與委任函

我們各執行董事與本公司於[●]訂立服務合約。服務合約項下委任期限的初始任期為自[**編纂**]起計三年，可根據其各自條款予以終止。服務合約可根據我們的組織章程細則及適用上市規則予以重續。

我們於[●]向各獨立非執行董事發出委任函。委任函項下委任期限的初始任期為自[**編纂**]起計三年，可根據其各自條款予以終止。委任函可根據我們的組織章程細則及適用上市規則予以重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司已訂立或擬訂立服務合約(於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

3. 董事薪酬

本集團就上一個完整財政年度(即截至2025年12月31日止年度)已付董事的薪酬及授予董事的實物福利總額為人民幣5.8百萬元。有關董事於往績記錄期的酬金的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9。

根據本文件日期生效的安排，我們估計本集團就截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬及董事應收的實物福利總額將約為人民幣5.9百萬元。

D. [編纂]前股權激勵計劃

目的

[**編纂**]前股權激勵計劃的主要目的是完善本集團的激勵機制，進一步增強本集團僱員參與者的工作積極性和創造力，促進本集團業績持續增長，在提升本集團價值的同時，為[**編纂**]前股權激勵計劃項下的合資格參與者帶來經濟效益，從而實現[**編纂**]前股權激勵計劃項下合資格參與者與本集團的共同發展。

管理

股東會為[**編纂**]前股權激勵計劃的最高決策機構，負責審議批准其制定、變更及終止。經股東批准，董事會負責[**編纂**]前股權激勵計劃的日常管理、實施、詮釋及修訂。

合資格參與者

[**編纂**]前股權激勵計劃項下的合資格參與者包括本集團的關鍵人員、其他僱員及董事會認定為需要獎勵的其他參與者。

[編纂]前股權激勵計劃的獎勵形式

參與者須根據[**編纂**]前股權激勵計劃授予的獎勵數目，以有限合夥人身份認購僱員持股計劃平台的合夥權益，從而以其有關僱員持股計劃平台有限合夥人的身份間接持有本公司股份。

禁售期及轉讓限制

根據[**編纂**]前股權激勵計劃所授出的獎勵將設有禁售期，自授出日期起至本公司於香港聯交所成功[**編纂**]起的法定禁售期屆滿日止(「**第一個禁售期**」)。於第一個禁售期內，未經董事會書面同意，承授人不得直接或間接出售於僱員持股計劃平台所持有的合夥權益。

於第一個禁售期屆滿後，限制性股份將在第一個禁售期後首個[**編纂**]日至24個月內的最後[**編纂**]日的解鎖期(「**第二個禁售期**」)分別按25%、25%及50%的比例分三批解鎖。於第二個禁售期內，倘相應合夥權益的相關股份少於100股，承授人可轉讓其全部合夥權益。

獎勵附帶的權利

僱員持股計劃平台的普通合夥人將代表[**編纂**]前股權激勵計劃項下的合資格參與者就獎勵相關股份行使投票權。[**編纂**]前股權激勵計劃項下的合資格參與者有權收取該等獎勵相關任何股份的任何股息或分派。

僱員持股計劃平台所持股份及根據[編纂]前股權激勵計劃授出的權益詳情

截至最後實際可行日期，僱員持股計劃平台的所有合夥權益已授予、歸屬並由合夥人認購，且相關登記已完成。僱員持股計劃平台合共持有本公司8,083,988股股份，佔緊接著[**編纂**]前本公司已發行股份總數的約13.06%。

截至最後實際可行日期，董事、高級管理層及關連人士根據[**編纂**]前股權激勵計劃於相關僱員持股計劃平台持有的合夥權益載列如下：

	於相關僱員持股計劃平台的合夥權益百分比	
姓名／名稱	舟山集成	威鑄燁芯
本公司董事及高級管理層		
李偉聰先生	90.15%	6.99%
黃義先生	–	10.14%
何偉先生	–	9.73%
姜春亮先生	–	7.30%
史帥先生	8.33%	5.84%
徐采芳女士	–	4.87%
本公司關連人士(上述所列董事除外)		
張小青先生(1)	–	2.43%
其他承授人		
–	1.52%	52.70%(2)

附註：

(1) 張小青先生為我們主要附屬公司的行政總裁。

(2) 概無承授人持有當中超過30%的合夥權益。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本集團任何成員公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

2. 訴訟

除本文件所披露者外及就董事所知，本集團任何成員公司概無未決或造成威脅的重大訴訟或申索。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[**編纂**]委員會[**編纂**]已發行及根據[**編纂**]將予發行的H股（包括因[**編纂**]獲行使而可能發行的任何額外H股）[**編纂**]及[**編纂**]。

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。獨家保薦人將就擔任[**編纂**]保薦人而收取費用1,150,000美元。

4. 無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，自2026年5月31日（即編製本集團最近一期綜合財務報表的日期）起，本集團的財務或貿易狀況概無任何重大不利變動。

5. 專家資質及同意書

本文件載列以下專家作出的聲明：

名稱	資質
廣發融資（香港）有限公司	進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見證券及期貨條例）的持牌法團
環球律師事務所	有關中國法律的法律顧問
安永會計師事務所	執業會計師及公眾利益實體核數師
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問
Hogan Lovells Cadwalader International LLP	有關美國外商投資及國際制裁法律的法律顧問

截至最後實際可行日期，上文所列專家概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（無論是否可依法強制執行）。

上文所列專家各自已發出且並無撤回彼等各自的同意書，表示同意刊發本文件，並按其各自所載形式及內容在本文件中載列其報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)的副本及引述其名稱。

6. 發起人

本公司於2022年6月28日改制為股份有限公司時，我們的發起人的資料如下：

股東	改制後所持股份數目	持股百分比
李先生	10,000,000	44.18%
舟山拓緯	3,333,334	14.73%
舟山集成	2,430,936	10.74%
OPPO廣東	1,289,168	5.70%
威鑄燁芯	902,397	3.99%
汾湖勤合創業投資	838,169	3.70%
元禾璞華	705,985	3.12%
英特爾	679,056	3.00%
鹽城創業投資	669,819	2.96%
湖北小米	615,732	2.72%
摩勤智能	541,255	2.39%
鋒霖創業投資	394,011	1.74%
鋒元創業投資	235,328	1.04%
總計	**22,635,190**	**100.00%**

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[**編纂**]及本文件所述相關交易向上述發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予現金、證券或其他福利。

7. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

8. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下使全部有關人士均受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有條文(罰則除外)約束。

9. 雙語文件

根據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條所規定的豁免，本文件的中英文版本分開刊發。

10. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

(i) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本授予佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款，亦無董事、發起人或名列本節「－E.其他資料－5.專家資質及同意書」的專家收取有關款項或利益；

(ii) 本集團任何成員公司資本概無為獲得現金而發行或建議發行或者以非現金方式發行為全部或部分繳足；

(iii) 概無董事或名列本節「－E.其他資料－5.專家資質及同意書」的專家於本集團任何成員公司發起過程中，或於本集團任何成員公司收購或出售或租賃或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益；及

(iv) 概無就認購或同意認購或者促使或同意促使認購本公司任何股份或債權證已付或應付佣金（惟不包括[**編纂**]的佣金）。

(b) 除本文件所披露者外：

(i) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；

(ii) 本公司並無未償還的可換股債務證券或債權證；

(iii) 本公司及其任何附屬公司概無任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；

(iv) 本集團任何成員公司資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；

(v) 緊接本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響；及

(vi) 概無董事在對本集團業務屬重大且於本文件日期仍然存續的任何合約或安排中擁有重大權益。